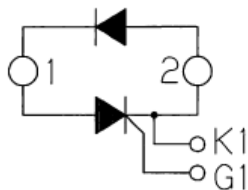


THYRISTOR

200A Avg 800 Volts

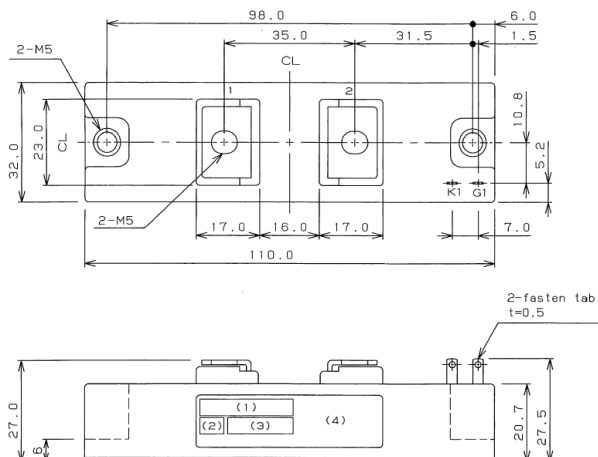
PAH200N8

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade PAH200N8	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	900	V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current		I_O (AV)	DC 通電 $T_c=104^{\circ}\text{C}$		200	A
サージオン電流 Surge On-State Current		I_{TSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		4000	A
電流二乗時間積 I Squared t		I^2t	2~10ms		80000	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current		di/dt	$V_D=2/3 V_{DRM}$, $I_{TM}=2 \cdot I_O$, $T_J=125^{\circ}\text{C}$ $I_G=200\text{mA}$, di/dt=0.2A/ μs		100	A/ μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power		P_{GM}			5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power		$P_{G(AV)}$			1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current		I_{GM}			2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage		V_{GM}			10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage		V_{RGM}			5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T_{Jw}	125~150°Cはサイリスタ部に順・逆電圧を 印加しないこと $T_J>125^{\circ}\text{C}$, Cannot be Biased for Thyristor		-40 ~ +150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T_{stg}			-40 ~ +125	°C
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V_{iso}	端子ーベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.		2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ~ 2.8	N・m

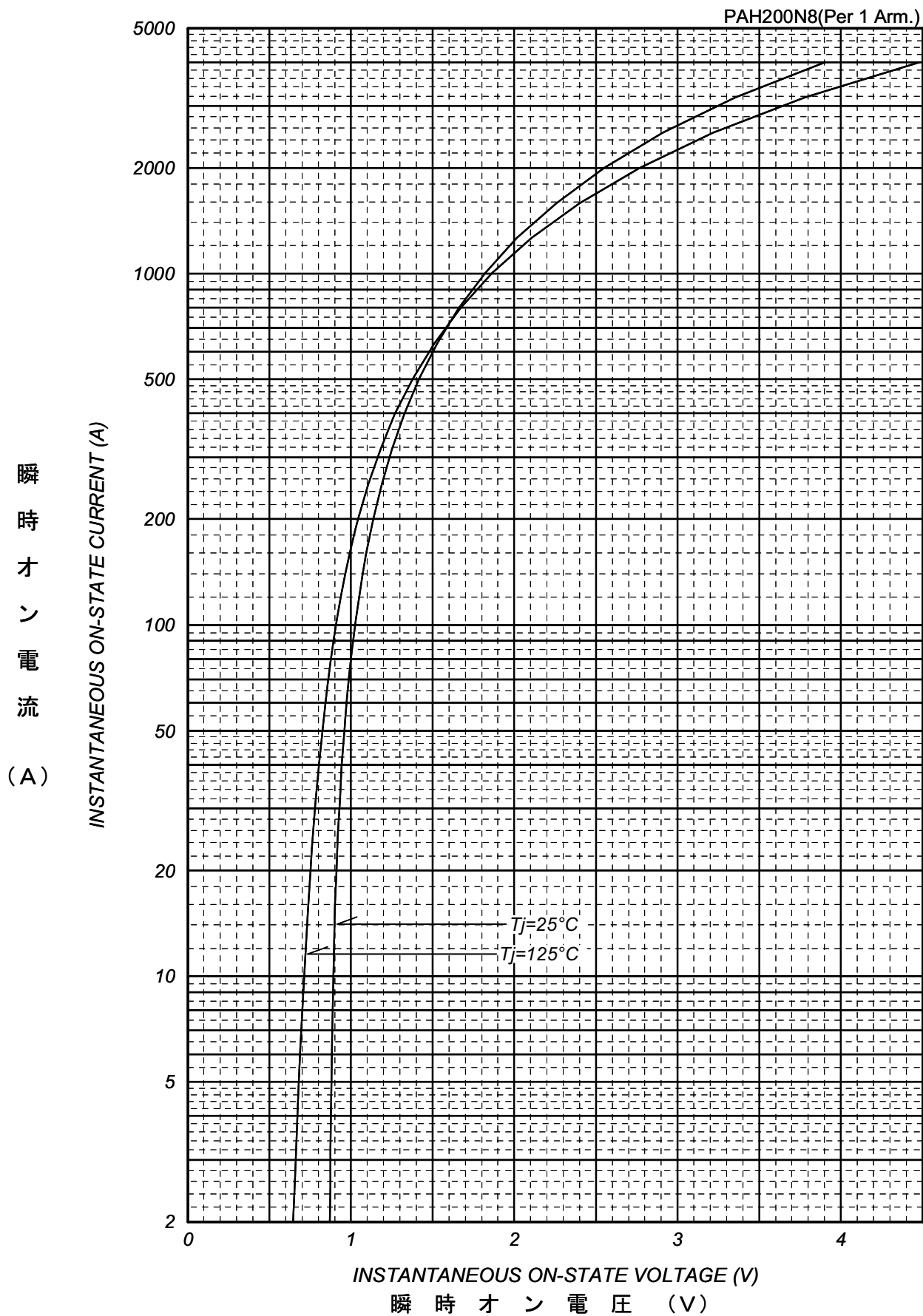
■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions		特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
				最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = V_{DRM}$				30	mA
ピークオン電圧 Peak Off-State Voltage	V_{TM}	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 600\text{A}$				1.5	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	$V_D = 6\text{V}$, $I_T = 1\text{A}$	$T_j = -40^{\circ}\text{C}$			300	mA
			$T_j = 25^{\circ}\text{C}$			150	
			$T_j = 125^{\circ}\text{C}$			80	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$V_D = 6\text{V}$, $I_T = 1\text{A}$	$T_j = -40^{\circ}\text{C}$			5	V
			$T_j = 25^{\circ}\text{C}$			3	
			$T_j = 125^{\circ}\text{C}$			2	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$		0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$		500			V/ μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t_q	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = I_o$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $dv/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$, $-di/dt = 20\text{A}/\mu\text{s}$			100		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $I_G = 200\text{mA}$, $di_G/dt = 0.2\text{A}/\mu\text{s}$			6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d				2		μs
立ち上がり時間 Rise Time	t_r				4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$			150		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$			100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 (Tc 測定点: チップ直下) Junction to Case				0.1	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(c-f)}$	ケースフィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased				0.2	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

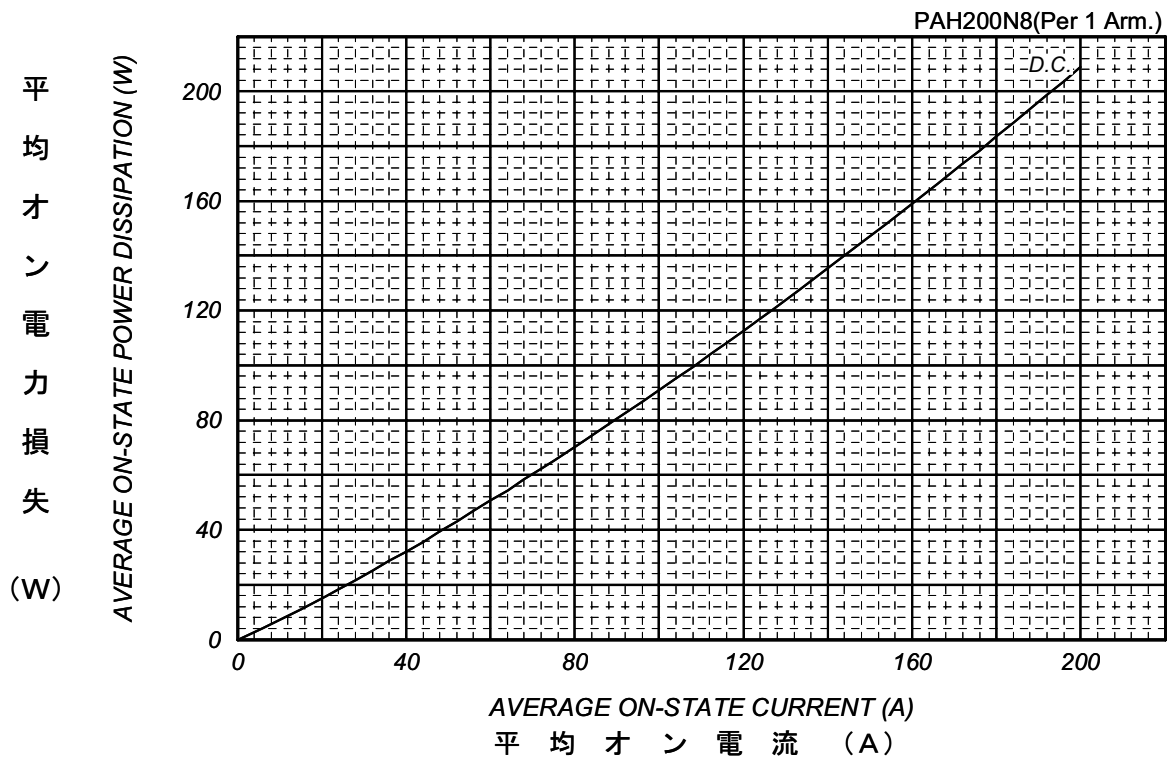
質量 --- 約200 g
Approximate Weight

*1 : 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

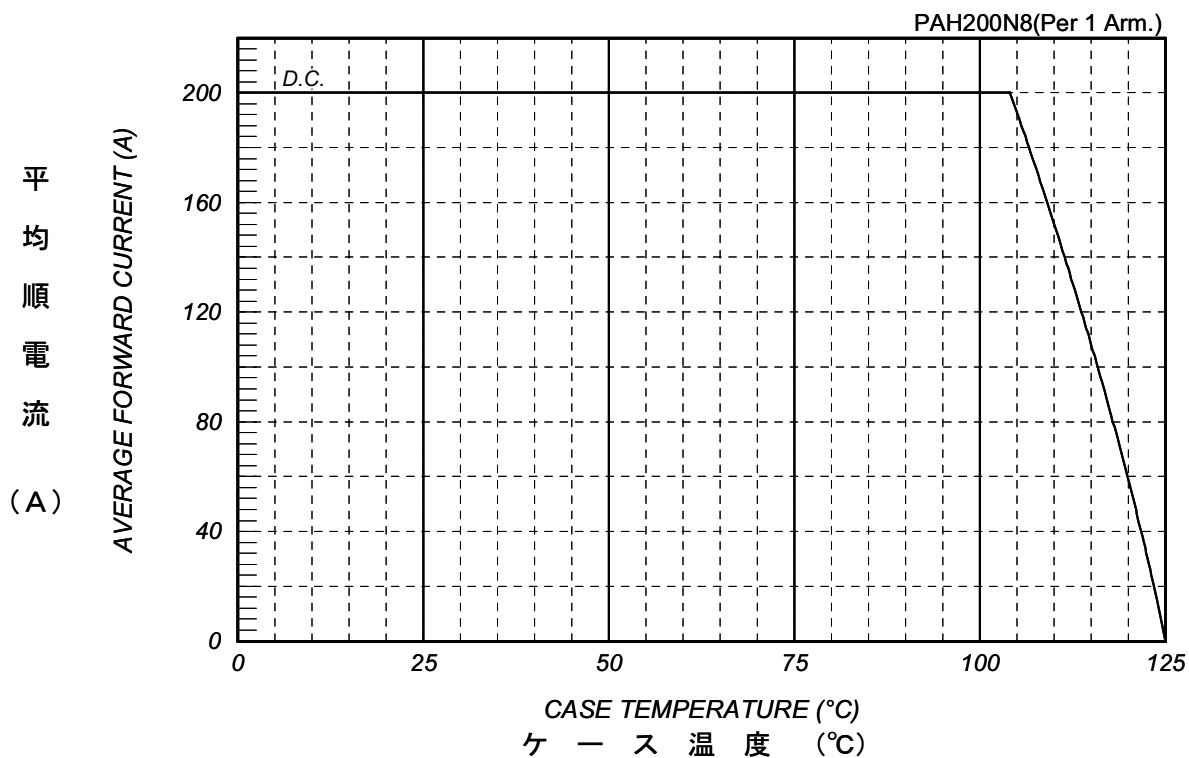
オン電圧特性 ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



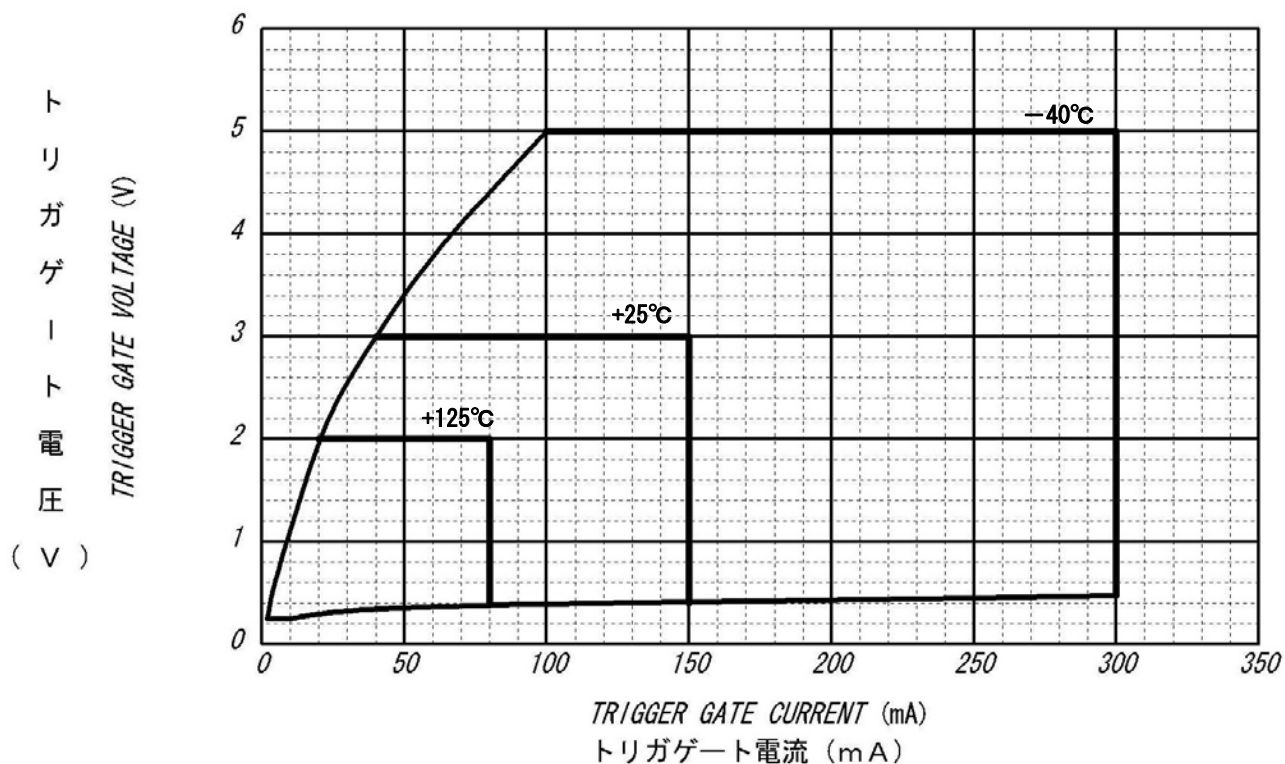
平均オン電力損失特性 AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



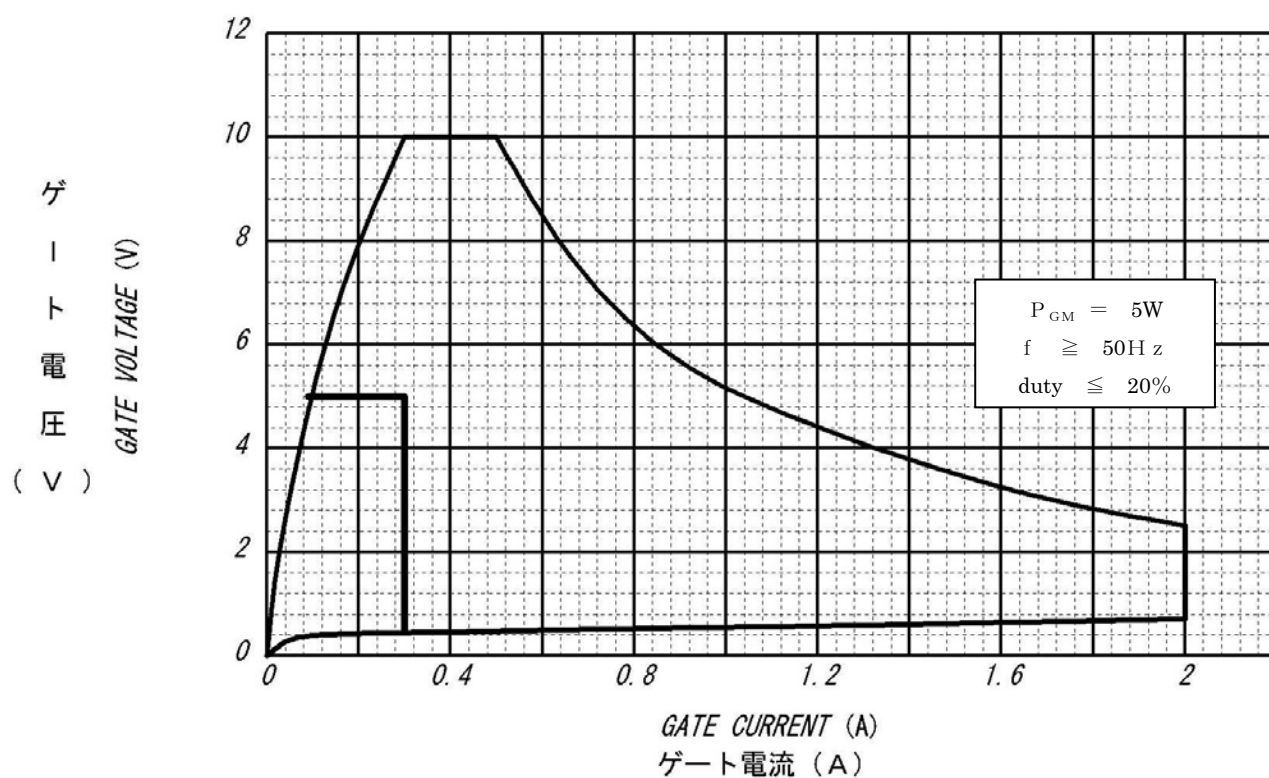
平均順電流－ケース温度定格 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



ゲート特性 GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格 GATE RATINGS

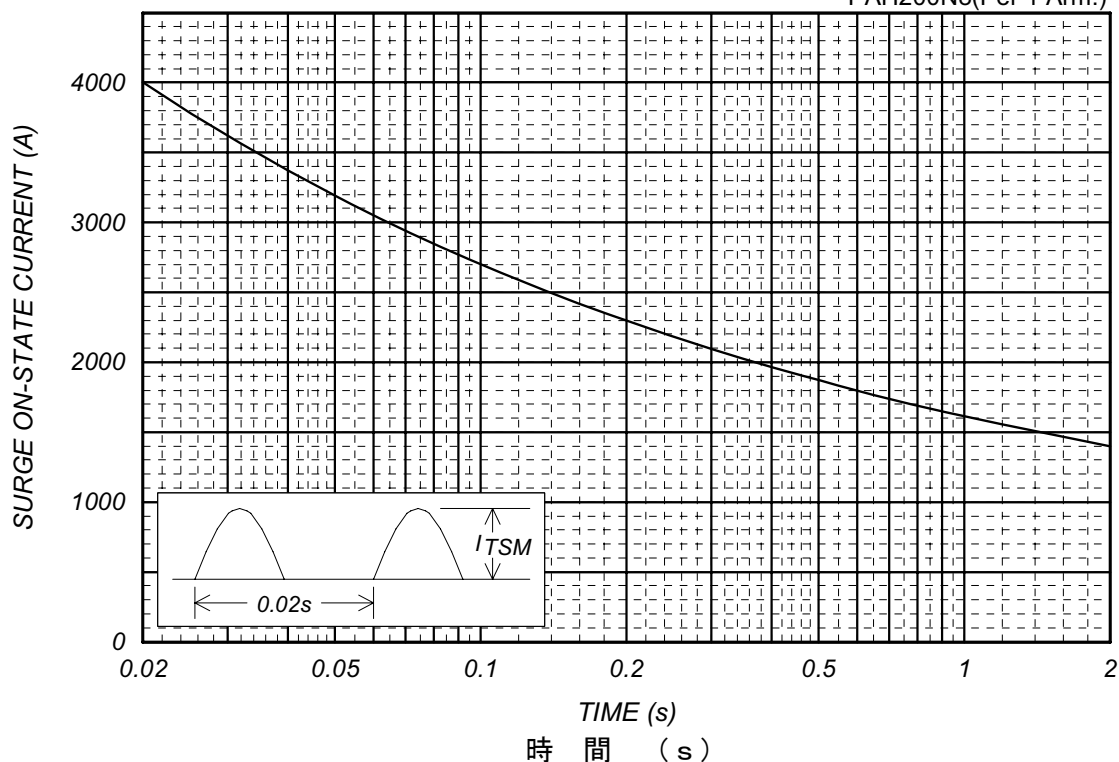


サージオン電流定格 SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, On Load

PAH200N8(Per 1 Arm.)

サ
ー
ジ
オ
ン
電
流
(A)



過渡熱抵抗特性 Transient Thermal Impedance

PAH200N8(Per 1 Arm.)

過
渡
熱
抵
抗
(°C/W)

